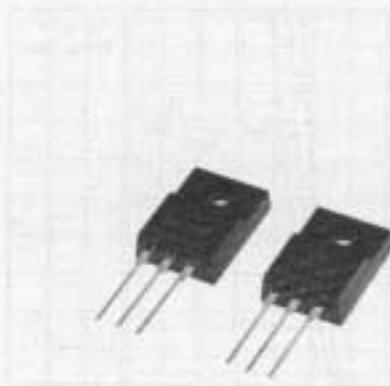


FS3KM-18A

高速度電力スイッチング用
Nチャンネルパワー-MOSFET

FS3KM-18A



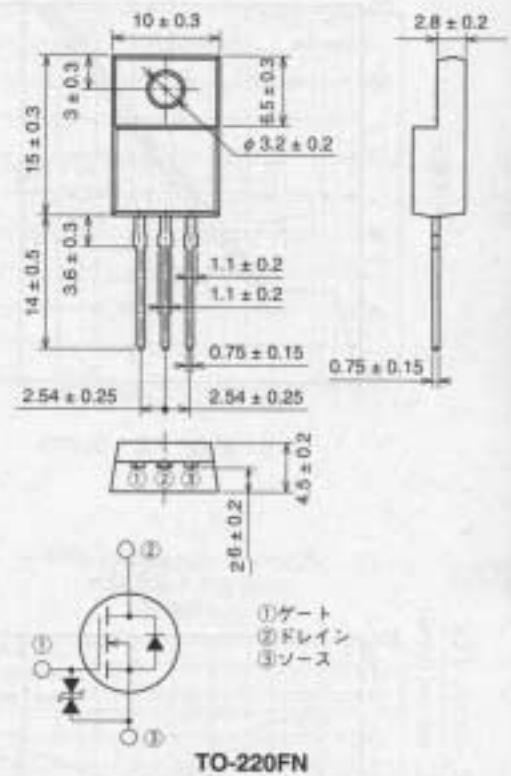
- V_{DSS} 900V
- r_{DS (ON)} (MAX) 4.0Ω
- I_D 3A
- V_{ISO} 2000V

用途

スイッチング電源、バッテリーチャージャ
プリンタ、複写機、ハードディスクドライブ
TV、VTR、パソコン等の電源

外形図

単位: mm



最大定格 (T_c = 25°C)

記号	項目	条件	定格値	単位
V _{DSS}	ドレイン・ソース間電圧	V _{GS} = 0V	900	V
V _{GSS}	ゲート・ソース間電圧	V _{DS} = 0V	±30	V
I _D	ドレイン電流		3	A
I _{DM}	ドレイン電流 (パルス)		9	A
P _D	ドレイン損失		30	W
T _{ch}	チャネル温度		-55 ~ +150	°C
T _{stg}	保存温度		-55 ~ +150	°C
V _{iso}	絶縁耐力	AC1分間、端子-ケース間	2000	V _{rms}
—	重量	標準値	2	g

FS3KM-18A

高速度電力スイッチング用
NチャンネルパワーMOSFET

電気的特性 (Tch = 25°C)

記号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
V _{(BR)DSS}	ドレイン・ソース間降伏電圧	I _D = 1mA, V _{GS} = 0V	900	—	—	V
V _{(BR)GSS}	ゲート・ソース間降伏電圧	I _{GS} = ±100μA, V _{DS} = 0V	±30	—	—	V
I _{GSS}	ゲート・ソース間漏れ電流	V _{GS} = ±25V, V _{DS} = 0V	—	—	±10	μA
I _{DSS}	ドレイン電流	V _{DS} = 900V, V _{GS} = 0V	—	—	1	mA
V _{GS(th)}	ゲート・ソース間しきい値電圧	I _D = 1mA, V _{DS} = 10V	2	3	4	V
r _{DS(on)}	ドレイン・ソース間オン抵抗	I _D = 1.5A, V _{GS} = 10V	—	3.08	4.00	Ω
V _{DS(on)}	ドレイン・ソース間オン電圧	I _D = 1.5A, V _{GS} = 10V	—	4.62	6.00	V
y _{fs}	小信号瞬伝導アドミタンス	I _D = 1.5A, V _{GS} = 10V	2.1	3.5	—	S
C _{iss}	小信号入力容量	V _{DS} = 25V, V _{GS} = 0V, f = 1MHz	—	770	—	pF
C _{oss}	小信号出力容量		—	77	—	pF
C _{rss}	小信号帰還容量		—	13	—	pF
t _{d(on)}	ターンオン遅延時間	V _{DD} = 200V, I _D = 1.5A, V _{GS} = 10V, R _{GEN} = R _{GS} = 50Ω	—	15	—	ns
t _r	上昇時間		—	15	—	ns
t _{d(off)}	ターンオフ遅延時間		—	90	—	ns
t _f	下降時間		—	25	—	ns
V _{SD}	ソース・ドレイン間電圧		I _S = 1.5A, V _{GS} = 0V	—	1.0	1.5
R _{th(ch-c)}	熱抵抗	チャンネルケース間	—	—	4.17	°C/W

定格特性図

